

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成27年7月9日(2015.7.9)

【公開番号】特開2014-167988(P2014-167988A)

【公開日】平成26年9月11日(2014.9.11)

【年通号数】公開・登録公報2014-049

【出願番号】特願2013-39378(P2013-39378)

【国際特許分類】

H 01 L 21/822 (2006.01)

H 01 L 27/04 (2006.01)

H 01 L 21/3205 (2006.01)

H 01 L 21/768 (2006.01)

H 01 L 23/522 (2006.01)

【F I】

H 01 L 27/04 H

H 01 L 21/88 Z

【手続補正書】

【提出日】平成27年5月22日(2015.5.22)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項1】

機能素子が形成された半導体基板と、

前記機能素子と導通している金属膜と、

前記金属膜と導通する配線電極を含む再配線層と、

を備え、

前記配線電極は、

平面視で一部が前記金属膜と重なり、前記半導体基板の表面と対向する平面状の第1配線電極と、

前記金属膜および前記第1配線電極を導通させる第1層間接続導体と、

平面視で一部が、前記第1層間接続導体から離れた前記第1配線電極の一部と重なり、前記再配線層の厚み方向で前記半導体基板と反対側に形成された第2配線電極と、

前記第1配線電極および前記第2配線電極を導通させる第2層間接続導体と、

を有し、

前記第2層間接続導体は、前記第1層間接続導体より径が小さく、

前記第1配線電極は、前記第2層間接続導体側の面積が前記第1層間接続導体側の面積よりも小さい、

半導体装置。